

平成26年7月17日
応用物理学会北海道支部
会員各位

応用物理学会北海道支部講演会のお知らせ

下記講演会を開催いたしますので、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。

演題：スピントロニクスデバイスの発展

講師：久保田 均 氏（産業技術総合研究所 ナノスピントロニクス研究センター 金属スピントロニクスチーム長）

日時：平成 26 年 7 月 28 日（月） 16:00～17:00

場所：北海道大学情報科学研究科 1 階 A12 講義室

主催：応用物理学会北海道支部

講演の要旨

2004 年に産総研で開発された結晶性 MgO トンネルバリアを有する強磁性トンネル接合 (MTJ) は、ハードディスクの再生磁気ヘッド、磁気抵抗型ランダムアクセスメモリ (MRAM) (16 メガビット) としてすでに実用化されている。現在は、この技術をベースに、ギガビットクラスの大容量 MRAM、新規スピントロニクスデバイスの開発が世界的に進められている。本セミナーでは、MTJ、スピントルク効果、並びに、それらを用いた高密度 MRAM、さらに、物理乱数発生器 (スピンダイス)、高周波素子などの新規スピントロニクスデバイスの開発状況について述べる。

世話人 山本眞史

北海道大学大学院情報科学研究科

電話：011-706-6439 yamamoto@nano.ist.hokudai.ac.jp